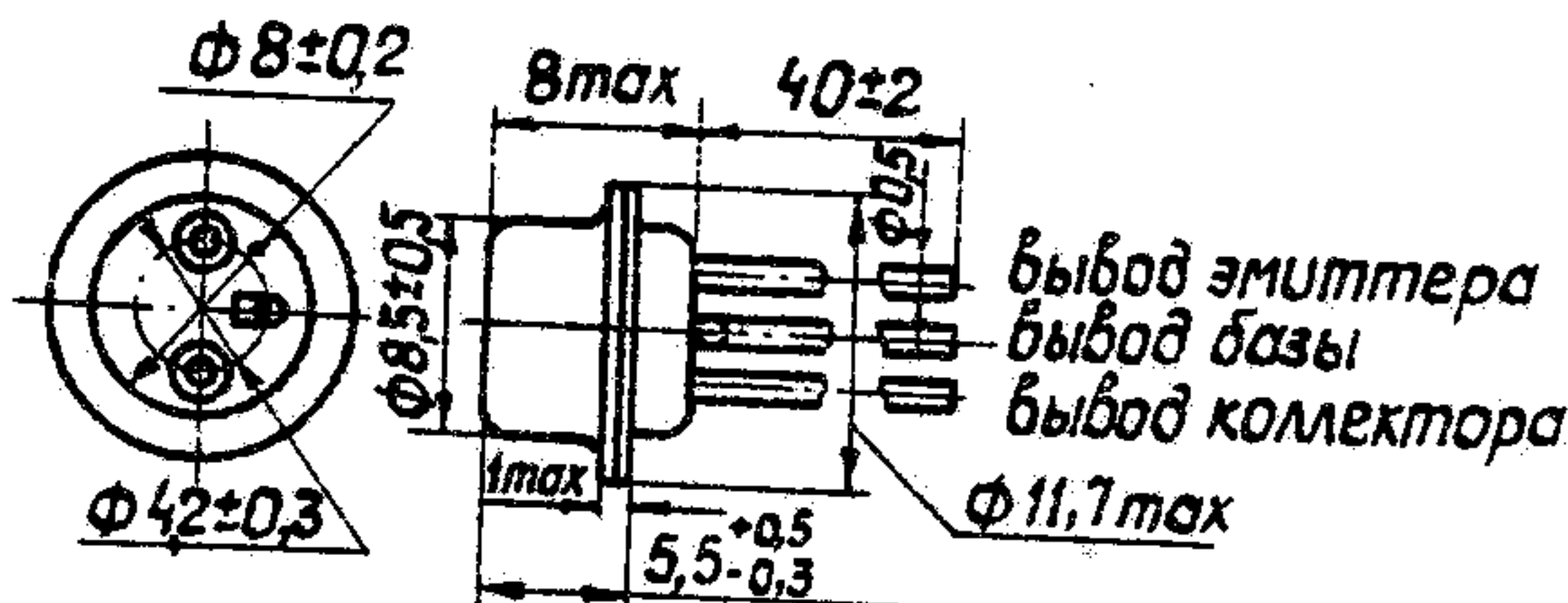


# Этикетка



Транзисторы типов:  
 1Т116А, 1Т116Б, 1Т116В, 1Т116Г  
 соответствуют требованиям  
 технических условий  
 ЮФ 3. 365. 014 ТУ



Масса не более 2 г.

Основные электрические параметры  
 при  $t_{окр.} = 20 \pm 5^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единицы измерения	Буквенное обозначе- ние	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент переда- чи тока в схеме с общим эмиттером ( $U_{кэ} = -1,0 \text{ В}$ , $I_{к} = 100 \text{ мА}$ ) 1Т116А, 1Т116Б, 1Т116Г, 1Т116В	$h_{21э}$	15 20	65 65
Обратный ток коллектор-эмит- тер, мкА ( $U_{кэ} = -15 \text{ В}$ , $U_{бэ} = +0,5 \text{ В}$ )	$I_{кэх}$		30

Наименование параметра, режим измерения, едини- цы измерения	Буквенное обозначе- ние	Норма	
		не менее	не более
Обратный импульсный ток коллектор-эмиттер, мА ( $E_k = -30 В$ )	$I_{кэк}, \mu$		1,0
Напряжение насыщения коллек- тор-эмиттер, В ( $I_k = 150 мА$ , $I_b = 30 мА$ )	$U_{кэ нас}$		0,25
Импульсное входное сопро- тивление в схеме с общим эмиттером в режиме боль- шого сигнала, Ом ( $E_k = -10 В$ , $I_k = 100 мА$ )	$h_{иэ}, \mu$	30	100
Временные параметры, мкс ( $E_k = -12,6 В$ , $E_{вэ} = +0,3 В$ для 1Т116А, 1Т116Б - $R_b = 51 Ом$ , для 1Т116В, 1Т116Г - $R_b = 27 Ом$ или 10 Ом, или без сопротив- ления)			
Время нарастания	$t_{нр}$	0,28	0,63
Время вершины 1Т116А, 1Т116В	$t_b$	2,1	2,5
1Т116Б, 1Т116Г		1,6	2,1
Время спада	$t_{сп}$	0,6	2,0
Предельная частота коэф- фициента передачи тока, МГц ( $U_{кб} = -5 В$ , $I_{э} = 1 мА$ )	$f_{h21}$	1	

Штамп ОТК



Штамп представи-  
теля заказчика

отк - 1120 -